

(第2版)

新编 中国 半导体器件 数据手册



■ 半导体二极管和
半导体光电子器件

《新编中国半导体器件数据手册》编委会

机械工业出版社

新编中国半导体器件数据手册

(第2版)

第1册

半导体二极管和半导体光电子器件

《新编中国半导体器件数据手册》编委会



机械工业出版社

本手册共分3册,第1册包括半导体二极管和半导体光电子器件;第2册为半导体三极管;第3册包括半导体数字集成电路、半导体模拟集成电路和附录。

本手册全面介绍了各类半导体器件的名称、型号、技术参数、外形图。附录1 半导体器件生产单位通信录中给出了360个半导体器件生产单位的名称、详细通信地址、邮政编码、电话号码和电报挂号等;附录2 国内、国外型号对照,给出了可互换的国内外型号的6万对。

本手册取材资料新、器件分类细、产品型号多、参数数据全,是机电设计人员、高校教学人员、电器维修人员、器件采购人员最实用的工具书。

DU09/08

图书在版编目(CIP)数据

新编中国半导体器件数据手册 第1册:半导体二极管和半导体光电子器件/《新编中国半导体器件数据手册》编委会编. —2版. —北京:机械工业出版社,1998.3
ISBN 7-111-06043-1

I. 新… II. 新… III. ①半导体器件-数据-中国-手册②半导体二极管-数据-中国-手册③光电器件:半导体器件-数据-中国-手册 IV. TN303-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 28367 号

出版人:马九荣 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)
责任编辑:张沪光
封面设计:姚毅
河北衡水冀峰印刷股份有限公司印刷·新华书店北京发行所发行
1998年3月第2版第2次印刷
787mm×1092mm^{1/16}·81.25印张 2026千字
5 001—8000册
定价:145.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

0000188

《新编中国半导体器件数据手册》编委会

主 编 毕克允

副主编 党冀平 姚振甫

常务编委 顾忠良 何耀宇

编写人员 (按姓氏笔划排序)

马建云 王 毅 王佳馥 田 璐 李渝生

何耀宇 汤西英 孟旭光 相元兰 赵旭霞

党冀平 顾忠良 蔡菊荣 董天明 潘树仁

前 言

微电子技术是当今世界最活跃的生产力。半导体技术是微电子技术的核心,它的发展及其在各个领域的广泛应用,极大地推动了科技进步和经济发展。

我国半导体与集成电路产业经历了 40 多年的发展,已经建成 360 多家工厂和研究单位,初步形成了一个门类比较齐全、品种基本配套的工业体系,为国民经济建设做出了重大贡献。但是,由于我国工业基础薄弱、投资强度不足、厂点布局分散等一系列因素,致使我国半导体器件与国内电子整机配套需要相比,尚有一定差距。因此,器件生产厂家和研究单位需要认真分析本行业的发展现状、明确自己的发展方向,才能适应国内外激烈竞争市场的要求。为此,电子工业部半导体专业情报网组织编写了《新编中国半导体器件数据手册》。

本手册分类新颖、编排合理、查阅简便,具有科学性;反映了国内最新产品的性能,具有先进性;所列参数齐全,可查找对应的生产厂家,具有实用性;收录的产品范围广、数量多、数据可靠,具有权威性。

然而,五年多来,随着开放的扩大和改革的深化,我国的半导体行业发展变化很大,数十个老的器件生产厂家退出了这一行业,又有数十个新建厂家尤其是合资企业加入了这个“大家族”。为了跟踪反映这些变化,更好地为器件用户和本手册的各类读者服务,根据本手册出版单位—机械工业出版社的建议,决定对 1992 年版《新编中国半导体器件数据手册》进行全面修订。总的修订原则是删去所有停产企业的所有产品和在产企业已停止生产的产品;增补在产企业的新产品和新建企业的产品。为节省篇幅,这次修订本删去利用率不高的原附录 2 半导体器件生产厂产品型号和第 3 册中意义不大的电路图。

本手册编写和修订过程中,都曾得到许多单位的大力支持,借手册第 2 版出版的机会,谨向提供产品性能参数的所有单位;向参与编写和修订工作的电子工业部第十三研究所、第四十七研究所、第五十五研究所、航天总公司西安微电子技术研究所、中国华晶电子集团公司、亚光电工厂、苏州半导体总厂、长春半导体厂、上海元件五厂和上海无线电七厂等单位表示深切的谢意。

尽管本手册的修订工作投入了很大的人力和财力,但在提高修订质量方面,肯定还会有不到之处,欢迎广大读者提出宝贵意见,以便下次修订时参考和采纳。



1998 年 1 月

编写说明

《新编中国半导体器件数据手册》囊括了全国各半导体器件生产厂家 1997 年以前生产的各类半导体器件产品。本手册由参数符号、型号-厂家索引、器件分类参数数据表、外形或管脚图、附录等内容组成。现将各部分所包括的内容及其各自的编排规则分别叙述如下：

1. 参数符号意义

在各类器件的参数数据表中,都使用了大量的参数符号。为便于使用者查阅,本手册将所用参数符号及其意义,按半导体二极管、半导体光电子器件、半导体三极管、半导体数字集成电路和半导体模拟集成电路五大部分列出。分立器件按拉丁字母序排列,小写字母排在大写字母前面,拉丁字母排在其他文种字母前面。集成电路参照国家标准 GB3431.1-82《半导体集成电路文字符号电参数文字符号》列出。

2. 型号-厂家索引

它由器件型号、生产单位名称以及该型号在参数数据表中所处的页码和序号三部分组成。它以先数字后字母的顺序排列。数字由小到大,当数字相同时,其前有“0”者排在前。字母按拉丁字母序排列。型号中出现的横线、斜线、括号等原则上不予考虑。但对数字相同字母亦相同的型号,无符号者排在前。

3. 参数数据表

按半导体二极管、半导体光电子器件、半导体三极管、半导体数字集成电路和半导体模拟集成电路五大部分进行分类。半导体二极管按功能、用途、结构、材料等分成 20 大类;半导体光电子器件按发光颜色、功能、用途、工作机理分成 5 大类;半导体三极管按频率、功率、功能、材料等分成 8 大类;半导体数字集成电路按功能、用途分成 12 大类;半导体模拟集成电路按功能、用途分成 8 大类。某些部分的某些大类,又根据不同的情况分为若干小类(详见各部分的分类目录)。

不同类别(包括小类)的器件均采用各自不同的表头。分立器件的表头,由序号栏、型号栏、若干主要参数(有的还含测试条件)栏、材料栏和外形图编号栏组成;集成电路的表头,由序号栏、型号栏、电路名称栏、工艺栏、若干主要参数栏和外形或管脚图编号栏组成。每类表头都标有相应分立器件或集成电路的分类名称。

为查阅方便,同一类别(包括小类)的器件有多张参数数据表时,每张参数数据表都重复列出该类器件的类别名称和表头内容(不用续表接排的形式,这是本手册编排上的一个特点)。

在参数数据表中,器件型号原则上是以表头中的第 1 项参数(主要参数)为依据,或按参数数字绝对值从小到大;或按性能从低到高;或按功能从简到繁;或按工艺(双极、MOS、混合)等等进行排序。若第 1 项参数相同时,再参考其它重要参数进行排序。

参数数据表中所列数据,除按规范化需要稍加处理和明显的差错必须更正外,完全依照生产厂家填报的数据汇编。

当表示分立器件的某参数的测试条件时,或将测试条件加方括号置于该项参数下,或在该参数栏的右侧用折线框出。

4. 器件外形或管脚图编号

本手册各部分的器件外形或管脚图,一律采用阿拉伯数字编号。由于半导体二极管和半导体光电子器件合装成第 1 册,半导体光电子器件外形图的编号接二极管连续往下编排;半导体数字集成电路和半导体模拟集成电路合装成第 3 册,半导体模拟集成电路外形或管脚图的编号接半

导体数字集成电路连续往下编排；半导体三极管自成第 2 册，外形图的编号从阿拉伯数字“1”开始依次往下编排。

5. 附录

本手册的附录 1 半导体器件生产单位通信录，它由单位名称、详细地址、邮政编码、电话号码和电报挂号等内容组成。省、直辖市、自治区的排列顺序按中华人民共和国民政部编的《中华人民共和国行政区划简册》(1989)的规定排列。然后排大、中、小城市，最后排县和县以下的单位。直辖市内单位的排列，优先排编有顺序号的单位。如：北京半导体器件一厂、北京半导体器件二厂、北京半导体器件三厂等等，然后再排其他无序的厂家。大城市内单位的排列原则同直辖市。附录 2 国内、国外型号对照，收集了国内、外可互换的型号约 6 万对，按型号索引规则排序，只要查到已知国外型号，就可知道可代换该 国外型号的国产型号。

目 录

前言
编写说明

第一部分 半导体二极管

半导体二极管参数符号意义	I-3
半导体二极管型号-厂家索引	I-6
半导体二极管参数数据表	I-231
1. 整流二极管	I-232
2. 高频整流二极管(包括阻尼、升压管)	I-366
3. 组合整流器	I-436
4. 硅整流堆	I-502
5. 稳压二极管	I-556
6. 恒流二极管	I-676
7. 混频二极管	I-688
8. 检波二极管	I-698
9. 微波检波二极管	I-702
10. 双基极二极管	I-706
11. 开关二极管	I-712
12. PIN 二极管	I-750
13. 变容二极管	I-750
14. 阶跃二极管	I-776
15. 隧道二极管	I-782
16. 崩越二极管	I-784
17. 耿氏二极管	I-786
18. 硅瞬变电压抑制二极管	I-792
19. 快恢复二极管	I-802
20. 混合类二极管	I-806
(二极管外形图见第二部分目录)	

第二部分 半导体光电子器件

半导体光电子器件参数符号意义	II-3
半导体光电子器件型号-厂家索引	II-4
半导体光电子器件参数数据表	II-63
1. 发射器件	II-64
1.1 发光二极管(包括阵列式)	II-64
1.2 平面发光显示器	II-142
1.3 LED 像素管	II-148
1.4 红外发光二极管(包括阵列式)	II-152
1.5 半导体激光器(包括阵列式)	II-158

2. 光敏器件	I-160
2.1 光敏二极管(包括阵列式)	I-160
2.2 光敏三极管和达林顿管	I-172
2.3 光伏电池(太阳能电池)	I-190
2.4 光控晶闸管	I-198
3. 光耦合器	I-200
4. 数码显示器	I-218
4.1 LED 数码显示器	I-218
4.2 CMOS-LED 光电组合显示器	I-258
5. 特殊器件	I-262
5.1 CCD 摄像传感器	I-262
5.2 荷重、加速度、压力传感器	I-264
5.3 力敏器件	I-268
5.4 磁敏三极管	I-274
5.5 霍尔器件	I-276
5.6 其他光电器件	I-278
5.7 杂类	I-280
二极管、光电子器件外形图	I-287

第 一 部 分
半 导 体 二 极 管

9810039

0800130

半导体二极管参数符号意义

a	电流温度系数	I_H	恒定电流
B_{V_T}	电压漂移——在给定的测试条件下, 稳定电压在一定时间间隔内变化的百分数	I_{OM}	最大正向(整流)电流——在规定条件下, 能承受的最大正向瞬时电流; 在电阻性负荷的工频正弦半波整流电路中允许连续通过锗检波二极管的最大工作电流
C_J	结电容	I_{OP}	工作电流
C_{J0}	零偏压结电容	I_P	峰点电流
C_T	总电容	I_R	反向直流电流(反向漏电流)——在测试反向特性时的反向电流; 硅堆在正弦半波电阻性负载的电路中, 在规定的反向电压下所通过的电流; 硅开关二极管两端加上反向工作电压 V_R 值时通过的电流; 稳压二极管在规定的反向电压下产生的漏电流; 整流管在正弦半波最高反向工作电压下的漏电流
C_{TO}	零偏压总电容	I_{R1}	常温下的最大反向电流
C_{TV}	电压温度系数——在测试电流下, 稳定电压的相对变化与环境温度的绝对变化的比值	I_{R2}	指定高温下的最大反向电流
ΔCT_{max}	电容互差值	I_{RS}	反向不重复平均电流
C_{J1}/C_{J2}	结电容变化比	I_{RO}	反向工作电流
d_{VT}	正向电压温度系数	I_{RR}	反向重复平均电流
E	电动势	$I_{s(is)}$	开关电流
E_M	烧毁能量	ISO	隔离度
E_{PM}	最大漏过尖峰脉冲能量	I_{SUR}	浪涌电流——通过锗检波二极管正向脉冲电流的最大值
e_p	峰值脉冲	I_{TRM}	通态重复峰值电流
f_M	最高工作频率	I_V	谷点电流
f_o	工作频率(中心频率范围)	I_Z	稳定电压电流(反向测试电流)——测试反向电参数时给定的反向电流
I_{B2}	基极调制电流	I_{ZM}	最大工作电流(最大稳压电流)
I_F	正向直流电流(额定整流电流或正向测试电流)——锗检波、开关管在规定的正向电压下极间通过的电流; 硅整流管、硅堆在规定的使用条件下, 在正弦半波中允许连续通过的最大工作电流(平均值); 硅开关管在额定功率下允许通过的二极管的最大正向直流电流(测稳压二极管正向电参数时给定的电流)	I_P/I_V	峰谷电流比
I_{FM}	正向峰值电流	L	变频损耗
$I_{F(OV)}$	正向过载平均电流	L_S	引线电感(串联电感)
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	L_{in}	插入损耗
I_{GAO}	阳栅极间漏电流	N_F	噪声系数
I_{GKS}	栅阴极间漏电流		

N_R	噪声比	t_S	存储时间(PIN 管开关时间)
P_+	正向平均功率	t_W	脉冲宽度
P_+	正向峰值功率	T_{JM}	最高结温——在规定使用条件下所允许的最高结温;稳压二极管在工作状态下 P-N 结的最高温度
P_-	反向平均功率	ΔT_{JM}	额定结温升
P_-	反向峰值功率	ΔT_m	($Q_C=0$ 时)最大温差即热端温度与冷端温度之差
P_D	耗散功率	T_S	储存温度
P_{DM}	最大耗散功率	T_{SS}	正切灵敏度
P_{in}	输入功率	V_R	反向峰值击穿电压——锗检波、开关管在给定的反向电流下的电压值;硅整流、开关管、硅堆反向为硬特性时,其反向伏安特性曲线急剧弯曲点的电压值(峰值),产品为软特性时,则其值为给定的反向漏电流下的电压值(峰值)
P_{MP}	最大耗散功率	V_{EB1}	双基极二极管的饱和压降
P_{in}	输入功率	V_{EB10}	发射极与第一基极反向电压
P_{MP}	最大漏过脉冲功率	V_F	正向电压降(通态平均电压)——通过规定的正向电流时在极间所产生的电压降
P_{MS}	最大承受脉冲功率	V_F	正向回峰电压——在隧道二极管中,表示当电流又回到峰值时的正向电压
P_O	输出功率	ΔV_F	正向电压降差
P_{OM}	最大输出功率	ΔV_{F2max}	正向电压互差值
P_t	总耗散功率	V_{max}	最大耐压
P_{ZM}	最大耗散功率——在给定的使用条件下稳压二极管允许承受的最大功率	V_n	中心电压——变容管的电容变化指数 n 值为最大时所对应的电压
Q	优值(品质因数)	V_{OP}	工作电压
Q_0	零偏压优值	V_P	峰点电压
Q_{cm}	($\Delta T=0$)最大产冷量(指定电流时)	V_{PP}	投影峰点电压
R	负(电)阻	V_R	反向工作电压——锗检波、硅开关二极管通过规定的反向电流在极间产生的电压,硅整流管等于或小于三分之二的击穿电压 V_B 值,在规定的使用条件下,在正弦半波电阻性负载的电路中,硅堆正常工作所允许施加的
$r_{BB}[R_{BB}]$	基极间电阻		
R_E	反向动态电阻		
$R_F[R_{fd}]$	正向微分电阻——在正向通导时,电流随电压指数地增加,呈现明显的非线性特性,在某一正向电压下,使电压增加微小量 ΔV ,正向电流相应增加 ΔI ,则 $\Delta V/\Delta I$ 叫微分电阻		
R_L	负载电阻		
R_O	低场电阻		
R_{rf}	射频电阻		
R_S	串联电阻		
R_{th}	热阻		
R_{VF}	视频电阻		
R_Z	动态电阻——在测试电流下,稳压二极管的电压微变量与通过稳压二极管电流微变量的比值		
t_{rr}	反向恢复时间(开关时间)		
t_r	阶跃时间(上升时间)		

最大反向峰值电压

V_{RM} 反向峰值电压(最高反向工作电压,最高测试电压)——一般等于或小于2/3的锗检波、开关二极管的击穿电压值(V_B)。硅堆最高测试电压 $V_{RM} = 1.5V_R \leq V_B$

V_{RRM} 反向重复峰值电压

V_{RSM} 反向不重复峰值电压

V_S 通向电压(信号电压、开关电压、起始电压)

V_{SWR} 电压驻波比

V_{th} 阈值电压

ΔV_T 弹回电压

V_V 谷点电压

V_T 补偿电压

V_Z 稳定电压——在稳压二极管稳压范围内,通过的反向电流为规定值时,在极间产生的电压降

Z_{jF} 中频阻抗

Z_{VF} 视频阻抗

α 电流灵敏度

β 电压灵敏度

η 效率(检波效率、变换效率)

η_V 分压比

λ 波长

τ 寿命

ϕ 接触电动势

半导体二极管型号-厂家索引

型 号	厂 家	页码-序号	型 号	厂 家	页码-序号
1/4W50	宽甸晶体管厂	I-650-28	1/2QL27F	乐山无线电厂	I-464-27
1/4W60	宽甸晶体管厂	I-652-44	1/2QL28D	乐山无线电厂	I-456-1
1/4W70	宽甸晶体管厂	I-654-48	1/2QL28F	乐山无线电厂	I-464-47
1/4W80	宽甸晶体管厂	I-656-45	1/2QLA	温州无线电七厂	I-436-41
1/4W90	宽甸晶体管厂	I-658-33	1/2QL-A	漳州得望电子企业公司	I-438-36
1/4W100	宽甸晶体管厂	I-658-44	1/2QLB	温州无线电七厂	I-442-8
1/4W110	宽甸晶体管厂	I-662-10	1/2QL-B	漳州得望电子企业公司	I-442-9
1/4W120	宽甸晶体管厂	I-662-40	1/2QLC	温州无线电七厂	I-444-37
1/4W130	宽甸晶体管厂	I-664-18	1/2QL-C	漳州得望电子企业公司	I-448-14
1/4W140	宽甸晶体管厂	I-664-29	1/2QLD	温州无线电七厂	I-448-15
1/4W150	宽甸晶体管厂	I-666-7	1/2QL-D	漳州得望电子企业公司	I-454-20
1/4W160	宽甸晶体管厂	I-666-34	1/2QLE	温州无线电七厂	I-452-8
1/4W170	宽甸晶体管厂	I-668-7	1/2QLF	温州无线电七厂	I-454-21
1/4W180	宽甸晶体管厂	I-668-26	1/2QLG	温州无线电七厂	I-462-9
1/4W190	宽甸晶体管厂	I-668-48	1/2QLH	温州无线电七厂	I-464-12
1/4W200	宽甸晶体管厂	I-670-12	1/2QLQ	温州无线电七厂	I-460-7
1/2ICQ	沈阳市半导体器件七厂	I-488-49	1/2W8	朝阳无线电元件厂	I-584-46
1/2QL	本溪市半导体器件厂	I-448-12	1/2W8	徐州半导体厂	I-584-47
1/2QL0.5A	泰州半导体厂	I-498-17	1/2W8	徐州半导体厂	I-584-48
1/2QL1A	泰州半导体厂	I-498-26	1/2W8A	朝阳无线电元件厂	I-584-50
1/2QL1.5A	揭阳半导体器件厂	I-448-13	1/2W8A	徐州半导体厂	I-584-49
1/2QL1.5A	常州市无线电元件七厂	I-454-19	1/2W8A	徐州半导体厂	I-586-1
1/2QL1.5A	常州市无线电元件七厂	I-460-6	1/2W8B	朝阳无线电元件厂	I-586-2
1/2QL1.5A	揭阳半导体器件厂	I-468-40	1/2W8B	徐州半导体厂	I-586-3
1/2QL1.5A	常州市无线电元件七厂	I-482-16	1/2W8B	徐州半导体厂	I-586-4
1/2QL1.5A	揭阳半导体器件厂	I-498-31	1/2W8C	朝阳无线电元件厂	I-586-5
1/2QL1.5A	揭阳半导体器件厂	I-482-16	1/2W8C	徐州半导体厂	I-586-6
1/2QL1.5A	揭阳半导体器件厂	I-460-6	1/2W8C	徐州半导体厂	I-586-7
1/2QL1.5A	泰州半导体厂	I-498-31	1/2W8.6	朝阳无线电元件厂	I-586-43
1/2QL1.5A	常州市无线电元件七厂	I-498-31	1/2W8.6	徐州半导体厂	I-586-44
1/2QL1.5A	揭阳半导体器件厂	I-454-19	1/2W8.6	徐州半导体厂	I-586-45
1/2QL-1.5A	丽水市晶体管厂	I-496-10	1/2W8.6A	朝阳无线电元件厂	I-586-46
1/2QL1.5A/30V	武汉市半导体器件三厂	I-438-35	1/2W8.6A	徐州半导体厂	I-586-47
1/2QL1.5A/50V	武汉市半导体器件三厂	I-442-7	1/2W8.6A	徐州半导体厂	I-586-48
1/2QL1.5A/100V	武汉市半导体器件三厂	I-448-3	1/2W8.6B	朝阳无线电元件厂	I-586-49
1/2QL1.5A/100V	揭阳半导体器件厂	I-448-3	1/2W8.6B	徐州半导体厂	I-586-50
1/2QL2A	泰州半导体厂	I-498-36	1/2W8.6B	徐州半导体厂	I-588-1
1/2QL26C	乐山无线电厂	I-446-46	1/2W8.6C	朝阳无线电元件厂	I-588-2
1/2QL26D	乐山无线电厂	I-454-3	1/2W8.6C	徐州半导体厂	I-588-3
1/2QL26F	乐山无线电厂	I-462-45	1/2W8.6C	徐州半导体厂	I-588-4
1/2QL26H	乐山无线电厂	I-472-31	1/2W9.1	朝阳无线电元件厂	I-590-38
1/2QL26K	乐山无线电厂	I-482-7	1/2W9.1	徐州半导体厂	I-590-39
1/2QL26M	乐山无线电厂	I-488-39	1/2W9.1	徐州半导体厂	I-590-40
1/2QL27C	乐山无线电厂	I-448-30	1/2W9.1A	朝阳无线电元件厂	I-590-41
1/2QL27D	乐山无线电厂	I-454-31	1/2W9.1A	徐州半导体厂	I-590-42

半导体二极管型号-厂家索引

型 号	厂 家	页码-序号	型 号	厂 家	页码-序号
1/2W9.1A	徐州半导体厂	I-590-43	1/2W11.1	徐州半导体厂	I-602-9
1/2W9.1B	朝阳无线电元件厂	I-590-44	1/2W11.1	徐州半导体厂	I-602-10
1/2W9.1B	徐州半导体厂	I-590-45	1/2W11.1A	朝阳无线电元件厂	I-602-11
1/2W9.1B	徐州半导体厂	I-590-46	1/2W11.1A	徐州半导体厂	I-602-12
1/2W9.1C	朝阳无线电元件厂	I-590-47	1/2W11.1A	徐州半导体厂	I-602-13
1/2W9.1C	徐州半导体厂	I-590-48	1/2W11.1B	朝阳无线电元件厂	I-602-14
1/2W9.1C	徐州半导体厂	I-590-49	1/2W11.1B	徐州半导体厂	I-602-15
1/2W9.6	徐州半导体厂	I-592-3	1/2W11.1B	徐州半导体厂	I-602-16
1/2W9.6	朝阳无线电元件厂	I-592-4	1/2W11.1C	徐州半导体厂	I-602-17
1/2W9.6	徐州半导体厂	I-596-2	1/2W11.1C	朝阳无线电元件厂	I-602-18
1/2W9.6A	朝阳无线电元件厂	I-592-5	1/2W11.1C	徐州半导体厂	I-602-7
1/2W9.6A	徐州半导体厂	I-592-6	1/2W11.6	朝阳无线电元件厂	I-604-12
1/2W9.6A	徐州半导体厂	I-596-3	1/2W11.6A	朝阳无线电元件厂	I-604-13
1/2W9.6B	朝阳无线电元件厂	I-592-7	1/2W11.6B	朝阳无线电元件厂	I-604-14
1/2W9.6C	朝阳无线电元件厂	I-592-8	1/2W11.6C	朝阳无线电元件厂	I-604-15
1/2W10A	上海光耀半导体器件厂	I-590-50	1/2W12A	上海光耀半导体器件厂	I-602-27
1/2W10B	上海光耀半导体器件厂	I-592-1	1/2W12B	上海光耀半导体器件厂	I-602-28
1/2W10C	上海光耀半导体器件厂	I-592-2	1/2W12C	上海光耀半导体器件厂	I-602-29
1/2W10.1	朝阳无线电元件厂	I-596-33	1/2W12.1	朝阳无线电元件厂	I-606-42
1/2W10.1	徐州半导体厂	I-596-33	1/2W12.1A	朝阳无线电元件厂	I-606-43
1/2W10.1A	朝阳无线电元件厂	I-596-34	1/2W12.1B	朝阳无线电元件厂	I-606-44
1/2W10.1A	徐州半导体厂	I-596-35	1/2W12.1C	朝阳无线电元件厂	I-606-45
1/2W10.1A	徐州半导体厂	I-596-34	1/2W12.6	朝阳无线电元件厂	I-610-29
1/2W10.1B	朝阳无线电元件厂	I-596-36	1/2W12.6A	朝阳无线电元件厂	I-610-30
1/2W10.1B	徐州半导体厂	I-596-36	1/2W12.6B	朝阳无线电元件厂	I-610-31
1/2W10.1B	徐州半导体厂	I-596-36	1/2W12.6C	朝阳无线电元件厂	I-610-32
1/2W10.1C	朝阳无线电元件厂	I-596-38	1/2W13.1	朝阳无线电元件厂	I-612-17
1/2W10.1C	徐州半导体厂	I-596-37	1/2W13.1A	朝阳无线电元件厂	I-612-18
1/2W10.1C	徐州半导体厂	I-596-38	1/2W13.1B	朝阳无线电元件厂	I-612-19
1/2W10.6	徐州半导体厂	I-600-19	1/2W13.1C	朝阳无线电元件厂	I-612-20
1/2W10.6	朝阳无线电元件厂	I-600-15	1/2W13.6	朝阳无线电元件厂	I-612-27
1/2W10.6	徐州半导体厂	I-600-15	1/2W13.6A	朝阳无线电元件厂	I-612-28
1/2W10.6A	徐州半导体厂	I-600-16	1/2W13.6B	朝阳无线电元件厂	I-612-29
1/2W10.6A	朝阳无线电元件厂	I-600-20	1/2W13.6C	朝阳无线电元件厂	I-612-30
1/2W10.6A	徐州半导体厂	I-600-20	1/2W14.1	朝阳无线电元件厂	I-616-11
1/2W10.6B	徐州半导体厂	I-600-21	1/2W14.1A	朝阳无线电元件厂	I-616-12
1/2W10.6B	朝阳无线电元件厂	I-600-22	1/2W14.1B	朝阳无线电元件厂	I-616-13
1/2W10.6B	徐州半导体厂	I-600-17	1/2W14.1C	朝阳无线电元件厂	I-616-14
1/2W10.6C	徐州半导体厂	I-600-23	1/2W14.6	朝阳无线电元件厂	I-616-27
1/2W10.6C	朝阳无线电元件厂	I-600-24	1/2W14.6A	朝阳无线电元件厂	I-616-28
1/2W10.6C	徐州半导体厂	I-600-18	1/2W14.6B	朝阳无线电元件厂	I-616-29
1/2W11A	上海光耀半导体器件厂	I-598-32	1/2W14.6C	朝阳无线电元件厂	I-616-30
1/2W11B	上海光耀半导体器件厂	I-598-33	1/2W30	徐州半导体厂	I-638-16
1/2W11C	上海光耀半导体器件厂	I-598-34	1/2W30	徐州半导体厂	I-638-17
1/2W11.1	朝阳无线电元件厂	I-602-8	1/2W40	上海光耀半导体器件厂	I-644-50

半导体二极管型号-厂家索引

型 号	厂 家	页码-序号	型 号	厂 家	页码-序号
1/2W40	徐州半导体厂	I-644-16	1/2W100	徐州半导体厂	I-660-21
1/2W40	徐州半导体厂	I-644-17	1/2W100-100V	朝阳无线电元件厂	I-660-31
1/2W42	朝阳无线电元件厂	I-648-20	1/2W110	宽甸晶体管厂	I-660-39
1/2W42-43V	朝阳无线电元件厂	I-650-6	1/2W110	徐州半导体厂	I-662-2
1/2W45	朝阳无线电元件厂	I-650-9	1/2W110	朝阳无线电元件厂	I-662-3
1/2W45-47V	朝阳无线电元件厂	I-650-35	1/2W110	上海光耀半导体器件厂	I-660-39
1/2W50	徐州半导体厂	I-648-31	1/2W110	徐州半导体厂	I-660-39
1/2W50	徐州半导体厂	I-648-32	1/2W110	徐州半导体厂	I-662-3
1/2W50	徐州半导体厂	I-650-29	1/2W110-110V	朝阳无线电元件厂	I-662-15
1/2W50	朝阳无线电元件厂	I-650-29	1/2W120	上海光耀半导体器件厂	I-662-20
1/2W50	上海光耀半导体器件厂	I-650-29	1/2W120	宽甸晶体管厂	I-662-34
1/2W50	宽甸晶体管厂	I-650-29	1/2W120	徐州半导体厂	I-662-35
1/2W50-51V	朝阳无线电元件厂	I-652-7	1/2W120	朝阳无线电元件厂	I-662-35
1/2W60	徐州半导体厂	I-652-26	1/2W120	徐州半导体厂	I-662-20
1/2W60	徐州半导体厂	I-652-27	1/2W120	徐州半导体厂	I-662-34
1/2W60	朝阳无线电元件厂	I-652-28	1/2W120-120V	朝阳无线电元件厂	I-662-44
1/2W60	上海光耀半导体器件厂	I-652-26	1/2W130	徐州半导体厂	I-662-48
1/2W60	宽甸晶体管厂	I-652-27	1/2W130	朝阳无线电元件厂	I-664-12
1/2W60	徐州半导体厂	I-652-28	1/2W130	上海光耀半导体器件厂	I-664-13
1/2W60-56V	朝阳无线电元件厂	I-654-49	1/2W130	宽甸晶体管厂	I-664-12
1/2W60-62V	朝阳无线电元件厂	I-654-19	1/2W130	徐州半导体厂	I-664-13
1/2W70	徐州半导体厂	I-654-25	1/2W130	徐州半导体厂	I-664-12
1/2W70	朝阳无线电元件厂	I-654-26	1/2W130	徐州半导体厂	I-664-12
1/2W70	上海光耀半导体器件厂	I-654-25	1/2W130-130V	朝阳无线电元件厂	I-664-21
1/2W70	宽甸晶体管厂	I-654-25	1/2W140	朝阳无线电元件厂	I-664-26
1/2W70	徐州半导体厂	I-654-26	1/2W140	宽甸晶体管厂	I-664-27
1/2W70-68V	朝阳无线电元件厂	I-656-2	1/2W140	徐州半导体厂	I-664-28
1/2W70-75V	朝阳无线电元件厂	I-656-38	1/2W140	上海光耀半导体器件厂	I-664-29
1/2W80	宽甸晶体管厂	I-656-15	1/2W140	徐州半导体厂	I-664-26
1/2W80	徐州半导体厂	I-656-33	1/2W140	徐州半导体厂	I-664-27
1/2W80	朝阳无线电元件厂	I-656-34	1/2W140-140V	朝阳无线电元件厂	I-666-2
1/2W80	上海光耀半导体器件厂	I-656-15	1/2W150	徐州半导体厂	I-666-3
1/2W80	徐州半导体厂	I-656-34	1/2W150	宽甸晶体管厂	I-666-5
1/2W80	徐州半导体厂	I-656-15	1/2W150	朝阳无线电元件厂	I-666-6
1/2W80-82V	朝阳无线电元件厂	I-658-25	1/2W150	上海光耀半导体器件厂	I-666-3
1/2W90	宽甸晶体管厂	I-658-5	1/2W150	徐州半导体厂	I-666-5
1/2W90	徐州半导体厂	I-658-30	1/2W150	徐州半导体厂	I-666-6
1/2W90	朝阳无线电元件厂	I-658-5	1/2W150-150V	朝阳无线电元件厂	I-666-21
1/2W90	上海光耀半导体器件厂	I-658-30	1/2W160	徐州半导体厂	I-666-26
1/2W90	徐州半导体厂	I-658-5	1/2W160	宽甸晶体管厂	I-666-28
1/2W90-91V	朝阳无线电元件厂	I-660-14	1/2W160	朝阳无线电元件厂	I-666-29
1/2W100	宽甸晶体管厂	I-658-45	1/2W160	上海光耀半导体器件厂	I-666-26
1/2W100	徐州半导体厂	I-660-20	1/2W160	徐州半导体厂	I-666-28
1/2W100	朝阳无线电元件厂	I-660-21	1/2W160	徐州半导体厂	I-666-29
1/2W100	上海光耀半导体器件厂	I-660-21	1/2W160-160V	朝阳无线电元件厂	I-666-49